

## 第166回 研究集会 詳細

1. 日時 : 2013年11月14日(木) 10:00-16:40  
: 2013年11月15日(金) 10:00-15:50
2. 場所 : 機械振興会館 地下2階 研修1号室

(〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 <http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/>)

3. オーガナイザー : 国清 辰也 <ルネサスエレクトロニクス SDM>、廣木 彰 <京都工織大>
4. 担当 : 林 洋一 <ラピスセミコンダクタ>、日高 剛 <パナソニック>
5. テーマ : プロセス・デバイス・回路シミュレーションおよび一般
6. 参加費 : 分科会員 2000円、非分科会員 4000円
7. 共催 : 電子情報通信学会 シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

### プログラム

11月14日(木)

0. オープニングトーク 10:00-10:05  
廣木 彰 <モデリング研究委員会>  
座長 廣木 彰 <京都工芸繊維大学>
1. [招待講演] 2013 SISPAD レビュー ~ 輸送, 信頼性 ~ 10:05-10:50  
森 伸也 <阪大>
2. [招待講演] 2013 SISPAD レビュー ~ 併設ワークショップ1 ~ 10:50-11:35  
植松真司 <慶大>
- 昼食 11:35-13:00  
座長 安斎 久浩 <ソニー>
3. [招待講演] 計算科学に基づく電子デバイス設計の現状 13:00-13:50  
白石賢二 <名大>
4. 低温RTAにおけるSi中のSの挙動とS<sub>2</sub>形成の原子レベルシミュレーション 13:50-14:15  
金村貴永、加藤弘一、谷本弘吉、青木伸俊、豊島義明 <東芝>
5. 窒化シリコン中の窒素空孔に導入された元素が電子トラップ準位に与える影響 14:15-14:40  
園田賢一郎、佃 栄次、谷沢元昭、石川清志、山口泰男 <ルネサス>
- 休憩 14:40-15:00  
座長 山川真弥 <ソニー>
6. [招待講演] シリコントライゲートナノワイヤトランジスタの低周波ノイズ特性解析 15:00-15:50  
齋藤真澄、太田健介、田中千加、沼田敏典 <東芝>
7. [招待講演] 量子エネルギー輸送モデルを用いた先端MOSFETシミュレーション 15:50-16:40  
鍾 菁廣、小田中紳二 <阪大>

11月15日(金)

- 座長 鎌倉良成 <大阪大学>
8. シリコンナノワイヤトランジスタの解析的ドレイン電流モデルとデバイス設計 10:00-10:25  
田中千加 1、萩島大輔 1、内田 建 2、沼田敏典 1 <東芝 1、慶大 2>

9. DIBL効果を取り入れた弾道・準弾道GAA-MOSFETのコンパクトモデル 10:25-10:50  
 程 賀 1、宇野重康 2、中里和郎 1 <名大 1、立命大 2>
10. Pt/TiO<sub>2</sub>/Pt系の抵抗変化現象の物理モデルとシミュレーションによる検証 10:50-11:15  
 近藤祐介、大村泰久 <関西大 >
11. Double-gate Lateral Tunnel FETのデバイスモデル 11:15-11:40  
 大村泰久 1、佐藤大貴 1、佐藤伸吾 1、アブヒジト マリック 2 <関西大 1、カルカッタ大 2>
- 昼食 11:40-13:00  
 座長 森 伸也 <大阪大学>
12. ジャンクションレストランジスタにおけるNEGF法を用いたデバイスシミュレーション  
 ~ 不純物散乱と遮蔽の影響の考察 ~ 13:00-13:25  
 植田暁子 1、Mathieu Luisier 2、本多周太 1、吉田勝尚 1、佐野伸行 1  
 <筑波大 1、チューリッヒ工科大 2>
13. ウィグナーモンテカルロ法を用いた極微細III-V MOSFETの量子輸送解析 13:25-13:50  
 大森正規 1、木場隼介 1、前川容佑 1、土屋英昭 1,3、鎌倉良成 2,3、森 伸也 2,3、小川真人 1  
 <神戸大 1、阪大 2、JST 3>
14. モンテカルロ法を用いたSiナノ構造の熱電変換性能に関する解析 13:50-14:15  
 インドラ ムル アディシロ 1、久木田健太郎 1、鎌倉良成 1,2 <阪大 1、JST CREST 2>
- 休憩 14:15-14:35  
 座長 園田賢一郎 <ルネサスエレクトロニクス>
15. MOSFETの1/f雑音におけるHoogeパラメータの統合モデル 14:35-15:00  
 大村泰久 <関西大>
16. チャネルインプラによるランダム・テレグラフ・ノイズの変調及び移動度向上によるノイズ低減の検討 15:00-15:25  
 陳 杰智、東 悠介、平野 泉、三谷祐一郎 <東芝研究センタ>
17. MOSFETの実効チャネル長の再考 15:25-15:50  
 寺田和夫、讃井和彦、辻 勝弘 <広島市大>

以上